

关键指标

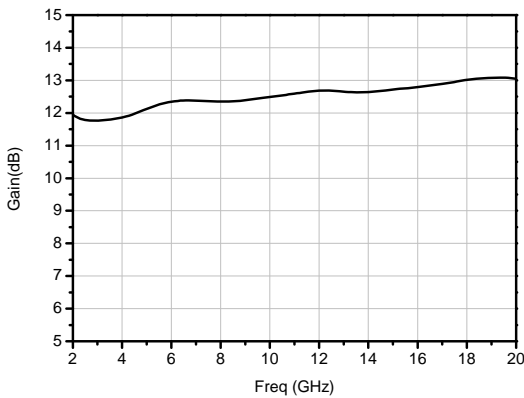
频率: 2~20GHz
增益: 12.5dB
1dB 压缩点输出功率: 28dBm
3dB 压缩点输出功率: 29.5dBm
电压/电流: +10V/292mA
芯片尺寸: 2.6mm×1.4mm

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+10V, V_{g1}=-1.35V)

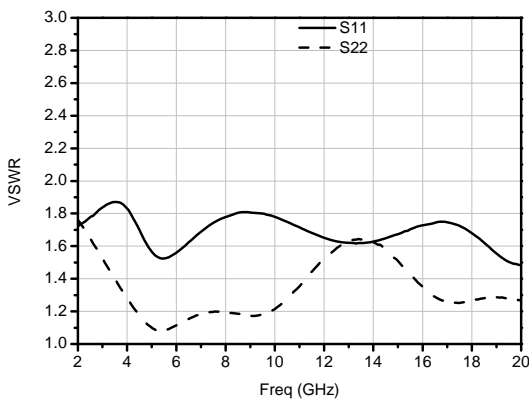
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~20		
增益(dB)	-	12.5	-
增益平坦度(dB)	-	±0.8	-
输入驻波	-	1.7	-
输出驻波	-	1.4	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	28	-
P-1 功率附加效率	-	17%	-
3dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	29.5	-
P-3 功率附加效率	-	22%	-
静态电流 (mA)	-	292	-

典型测试曲线 (V_{dd}=+10V)

增益

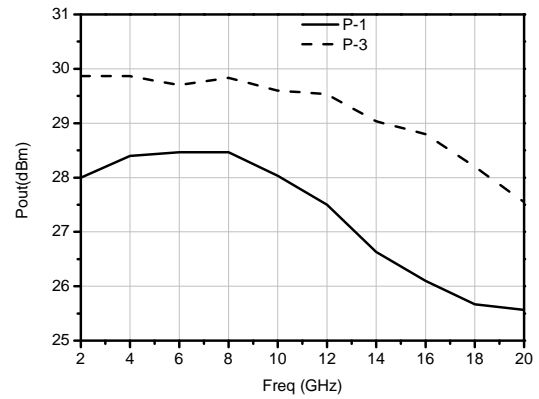


驻波



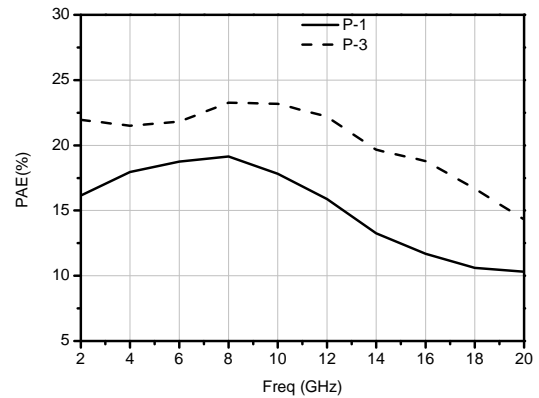
输出功率

(V_{dd}=+10V, V_{g1}=-1.35V, I_D=292mA)

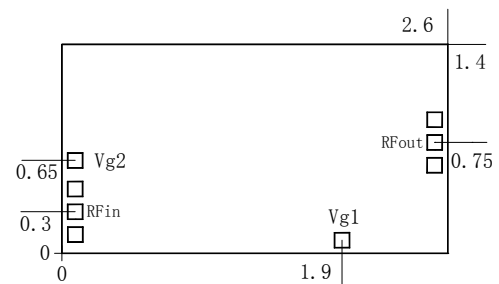


功率附加效率

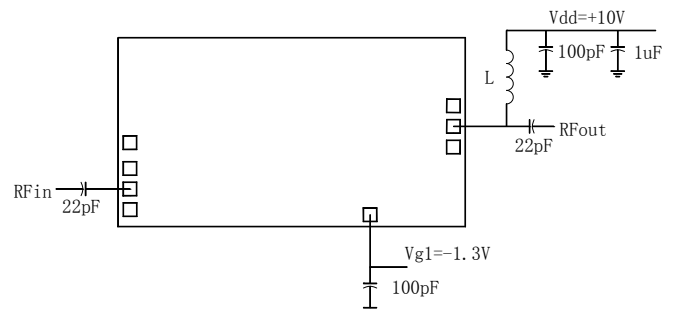
(V_{dd}=+10V, V_{g1}=-1.35V, I_D=292mA)



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



L: 宽带电感, 推荐型号: CCM19T40-002

绝对额定最大值

工作电压	+12V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端均无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。